

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВЕЩЕСТВО

PACS 63.20.Kr; 42.65.Re

Поглощение фемтосекундного лазерного импульса металлами и возможность определения эффективных частот электрон-электронных столкновений

В.А.Исаков, А.П.Канавин, С.А.Урюпин

Предложен подход к описанию поглощения греющего электроны фемтосекундного лазерного импульса, который взаимодействует с металлом в условиях высокочастотного скин-эффекта. Показано, как по измерениям коэффициента поглощения или отражения фемтосекундного импульса можно определить эффективные частоты электрон-электронных столкновений, идущих с перебросом квазиимпульса.

Ключевые слова: коэффициент поглощения, электрон-электронные столкновения, процессы переброса.

Оптические и кинетические свойства металлов, находящихся в состоянии, близком к термодинамически равновесному, изучены весьма детально (см., напр., [1–3]). Для большинства нормальных металлов в широком диапазоне температур эти свойства в значительной степени определяются столкновениями электронов с фононами, которые характеризуются эффективными частотами столкновений ν_{ep} , превышающими частоты электрон-электронных столкновений ν_{ee} . Иное положение имеет место в условиях, когда металл взаимодействует с достаточно мощным фемтосекундным импульсом лазерного излучения [4–6]. При поглощении лазерного импульса электроны быстро нагреваются до температуры, значительно большей температуры решетки, которая во время действия импульса остается сравнительно холодной, т. к. характерное время передачи энергии от электронов к решетке больше или порядка нескольких пикосекунд. Вследствие нагрева электронов эффективная частота электрон-электронных столкновений ν_{ee} возрастает пропорционально T^2 [7, 8], а зависящая от температуры решетки T_{lat} частота электрон-фононных столкновений ν_{ep} остается практически неизменной. Уже при температурах электронов, превышающих две-три тысячи градусов Кельвина, реализуются условия, когда $\nu_{ee} \gg \nu_{ep}$. При этом как поглощение энергии лазерного импульса, так и вынос тепла из скин-слоя в основном определяются электрон-электронными столкновениями, в том числе происходящими с перебросом квазиимпульса.

Высокая скорость электрон-электронных столкновений позволяет использовать понятие температуры электронов при описании оптических и кинетических явлений в металле, начиная с времен порядка нескольких фемтосекунд. Количественное описание этих явлений предполагает учет реальной пространственной структуры поля в металле и неоднородности температуры электронов. Именно такой подход к описанию взаимодействия с ме-

таллом греющего электроны фемтосекундного импульса предлагается в настоящей работе применительно к условиям высокочастотного скин-эффекта. В основу описания положено уравнение для температуры электронов, учитывающее их нагрев в скин-слое из-за электрон-фононных и электрон-электронных столкновений, идущих с перебросом квазиимпульса, и охлаждение вследствие выноса тела из скин-слоя. Плотность потока тепла также зависит от частот столкновений электронов с фононами и между собой, но величины этих частот отличаются от тех, которые определяют поглощение поля.

Следуя [8], примем, что существуют две частоты электрон-электронных столкновений, различающихся независимыми параметрами a и b . Это частота $\nu_a = a(k_B T)^2 \times (\hbar \epsilon_F)^{-1}$, определяемая коэффициентом поглощения, и частота $\nu_b = b(k_B T)^2 / \hbar \epsilon_F$, определяемая потоком тепла. Здесь k_B – постоянная Больцмана; \hbar – постоянная Планка; ϵ_F – энергия Ферми. Коэффициент поглощения находится из интегрального соотношения, которое учитывает неоднородность как поля, так и температуры электронов, что отличает предлагаемый подход от обычно используемой модели Друде. Ниже найдено численное решение уравнения для температуры и установлены простые асимптотические формулы, описывающие эволюцию во времени температуры электронов и коэффициента поглощения. Показано, как по измерениям коэффициента поглощения на различных стадиях действия фемтосекундного импульса можно определить коэффициенты a и b .

С использованием предложенного подхода к описанию оптических свойств металла с горячими электронами проанализированы данные эксперимента [9] (см. также [10]), в котором изучена эволюция во времени коэффициента отражения пробного фемтосекундного импульса от мишени из золота, электроны которого нагреваются основным фемтосекундным импульсом. Из сравнения экспериментальных данных работы [9] и численных расчетов получены значения параметров a и b для золота, т. е. установлены эффективные электрон-электронные частоты столкновений. Простота подхода, предложенного для описания оптических свойств металла в условиях высокочастотного скин-эффекта, а также простота методики экспериментов, выполненных в [9], открывают

В.А.Исаков, А.П.Канавин, С.А.Урюпин. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский просп., 53
e-mail: kanavin@sci.lebedev.ru

Поступила в редакцию 19 мая 2006 г., после доработки – 24 июля 2006 г.

возможность определения электрон-электронных частот столкновений (в том числе протекающих с перебросом квазиимпульса) без трудоемких расчетов, предполагающих учет реальной зонной структуры металла.

Рассмотрим взаимодействие лазерного импульса с металлом, занимающим полупространство $z > 0$. Примем, что импульс падает нормально на границу металла, а его электрическое поле

$$E(z, t) = E_0 \exp \left[-\frac{1}{2t_p^2} \left(t - \frac{z}{c} \right)^2 \right] \sin \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right], \quad (1)$$

где E_0 – вектор с составляющими $E_0, 0, 0$; t_p – длительность импульса; ω – частота; c – скорость света.

При взаимодействии лазерного излучения с металлами в видимом диапазоне частот сравнительно просто реализуются условия высокочастотного скин-эффекта, когда характерная частота излучения ω превышает эффективную частоту столкновений электронов с фононами и между собой v'_a , а расстояние, проходимое электронами за период изменения поля v_F/ω , мало по сравнению с шириной скин-слоя $d = c/\omega_{pl}$:

$$\omega \gg v'_a, \quad \frac{v_F}{\omega} \ll \frac{c}{\omega_{pl}}, \quad (2)$$

где v_F – скорость Ферми; $\omega_{pl} = (4\pi N e^2/m)^{1/2}$ – плазменная частота; e, m и N – заряд, масса и плотность электронов. Пренебрегая влиянием редких столкновений и имея в виду соотношение (1), в условиях (2) для поля в скин-слое приближенно получаем

$$E(z, t) = E(z) \exp \left(-\frac{t^2}{2t_p^2} \right) \cos \omega t, \quad (3)$$

где вектор напряженности поля $E(z)$ имеет составляющие $E(z), 0, 0$, и

$$E(z) = 2 \frac{\omega}{\omega_{pl}} E_0 \exp \left(-\frac{z}{d} \right). \quad (4)$$

Соотношения (3), (4) записаны в приближении $\omega t_p \gg 1$ и не учитывают малого отличия сдвига фазы поля в металле от $\pi/2$.

Поле вида (3), (4) поглощается в скин-слое из-за столкновений электронов с фононами и между собой. Диссипация поля, обусловленная затуханием Ландау, обычно незначительна и далее не учитываются. Пренебрегая изменением эффективной частоты столкновений v'_a за период $2\pi/\omega$, находим, что средняя за период мощность, поглощаемая в точке z ,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8\pi} \frac{\omega_{pl}^2}{\omega^2} v'_a(z, t) E^2(z) \exp \left(-\frac{t^2}{t_p^2} \right) \\ & \equiv \frac{4}{c} I(t) v'_a(z, t) \exp \left(-\frac{2z}{d} \right), \end{aligned} \quad (5)$$

где $I(t) = (c/8\pi) E_0^2 \exp(-t^2/t_p^2)$ – медленно изменяющаяся за время $2\pi/\omega$ плотность потока излучения. Интегрируя выражение (5) по координате z , найдем поглощаемую мощность, разделив которую на $I(t)$ получим коэффициент поглощения

$$A(t) = \frac{4}{c} \int_0^\infty dz v'_a(z, t) \exp \left(-\frac{2z}{d} \right), \quad (6)$$

который изменяется со временем по мере изменения эффективной частоты столкновений электронов. Вклад в v'_a дают столкновения электронов с фононами ($v_{ep,opt}$) и между собой (v_a), т. е. $v'_a = v_{ep,opt} + v_a$. При этом вклад в поглощение дают электрон-электронные столкновения, идущие с перебросом квазиимпульса. При температуре электронов $T \ll \varepsilon_F$ частоту v'_a можно представить в следующем виде [8]:

$$v_a = a \frac{\varepsilon_F}{\hbar} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2. \quad (7)$$

Соотношение (7) не учитывает зависимость v_a от частоты ω [11]. Такое приближение оправдано тем, что при низких температурах, когда $\hbar\omega \gg 2\pi k_B T$, в оптическом диапазоне частот видоизменяющаяся согласно [11] частота $v_a [1 + (\hbar\omega/2\pi k_B T)^2]$ не превышает $v_{ep,opt} \sim k_B T_{lat}/\hbar$, если температура решетки T_{lat} больше или порядка температуры Дебая. Теоретический расчет коэффициента a сопряжен с трудностями, обусловленными необходимостью учета реальной зонной структуры металла (см., напр., [3, 7, 12, 13]). Вместе с тем возможен и иной подход, когда a находится из измерений коэффициента поглощения греющего электроны фемтосекундного лазерного импульса. Такая возможность возникает при нагреве электронов за время, меньшее характерного времени передачи энергии от электронов к решетке, которое для типичных металлов составляет порядка нескольких пикосекунд. Если нагреть электроны до температуры, большей T_a , при которой $v_a(T_a) \simeq v_{ep,opt}$, или до температуры $T_a \simeq (\varepsilon_F/k_B)(\hbar v_{ep,opt}/a\varepsilon_F)^{1/2} \gg T_{lat}$, то их эффективная частота столкновений v'_a в основном будет определяться электрон-электронными столкновениями. При столь больших температурах коэффициент поглощения A обусловлен электрон-электронными столкновениями, идущими с перебросом квазиимпульса, а его величина зависит от неизвестного коэффициента a , что и позволяет найти значение последнего. С целью демонстрации такой возможности рассмотрим нагрев электронов в скин-слое.

Эволюция температуры электронов в металле описывается уравнением

$$C \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{4}{c} I(t) v'_a \exp \left(-\frac{2z}{d} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (8)$$

где $C = \pi^2 N k_B^2 T / 2\varepsilon_F$ – теплоемкость; $\lambda = C v_F^2 / 3v'_a$ – коэффициент теплопроводности электронов, зависящий от частоты столкновений $v'_a = v_{ep,\lambda} + v_\lambda$. Частоты $v_{ep,\lambda}$ и v_λ численно отличаются от электрон-фононной ($v_{ep,opt}$) и электрон-электронной (v_a) частот столкновений, определяющих коэффициент поглощения. Как и v_a , частота

$$v_\lambda = b \frac{\varepsilon_F}{\hbar} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2, \quad (9)$$

где численный коэффициент $b \neq a$.

Первое слагаемое в правой части уравнения (8) описывает нагрев электронов из-за поглощения энергии лазерного излучения в скин-слое, последнее слагаемое – перенос тепла в глубь металла. Оно записано в предположении, что длина свободного пробега v_F/v'_a меньше

характерного масштаба неоднородности температуры. Отметим, что использование понятия температуры, а тем самым и уравнения (8), для описания нагрева электронов оправданно, если характерное время изменения температуры велико по сравнению с обратной частотой электрон-электронных столкновений. Подчеркнем, что для того, чтобы частота электрон-электронных столкновений проявлялась в оптических свойствах металлов, она должна превышать частоту электрон-фононных столкновений, которая, например, для золота больше или порядка 10^{14} с^{-1} . Это означает, что для импульсов длительностью свыше 10 фс вклад нетермализованных электронов в коэффициент поглощения сильно подавлен.

Как уже отмечалось, влияние электрон-электронных столкновений на коэффициент поглощения возможно тогда, когда за время действия импульса электроны в скин-слое успевают нагреться до температуры, большей T_a . Для реализации такой возможности необходимо иметь достаточно большую плотность потока излучения I , при которой нагрев электронов происходит быстрее, чем их охлаждение вследствие ухода тепла из скин-слоя. С учетом этого далее примем, что

$$\frac{k_B T}{\varepsilon_F} > \frac{8I}{cN\varepsilon_F} > \frac{\pi^2}{3v_a'v_\lambda'} \left(\frac{v_F \omega_{pl}}{c} \right)^2 \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2, \quad T > T^*, \quad (10)$$

где $I = I(t = 0)$, а температура электронов превышает $T^* = \min(T_a, T_b)$ (T_b – температура, при которой $v_b(T_b) \simeq v_{ep,\lambda}$). Левое неравенство (10) обеспечивает малость $mv_E^2 = e^2 E^2(z)/m\omega^2$ – энергии осцилляций электронов в электрическом поле E , по сравнению с тепловой энергией электронов $k_B T$. Отметим, что по мере нагрева электронов область совместности левого и правого неравенств (10) расширяется благодаря увеличению отношения $k_B T/\varepsilon_F$.

Правое неравенство (10) позволяет пренебречь переносом тепла в уравнении (8). Тогда из (8) приближенно находим

$$\frac{v_a(T) + v_{ep,opt}}{v_a(T_0) + v_{ep,opt}} = \exp \left\{ \frac{8aIt_p}{\pi\sqrt{\pi}\hbar cN} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{t}{t_p} \right) \right] \exp \left(-\frac{2z}{d} \right) \right\}, \quad (11)$$

где $T_0 = T(t = -\infty)$ – температура электронов до начала воздействия лазерного импульса; $\operatorname{erf}(x) = (2/\sqrt{\pi}) \int_0^x dt \exp(-t^2)$ – функция ошибок. Соотношение (11) имеет место при $k_B T < \varepsilon_F$, что налагает ограничение на длительность лазерного импульса. Принимая во внимание соотношение (11), из (6) находим коэффициент поглощения

$$\frac{A(t)}{A(t = -\infty)} = \frac{\pi\sqrt{\pi}\hbar cN}{8aIt_p} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{t}{t_p} \right) \right]^{-1} \times \left\{ \exp \left[\frac{8aIt_p}{\pi\sqrt{\pi}\hbar cN} \left(1 + \operatorname{erf} \left(\frac{t}{t_p} \right) \right) \right] - 1 \right\}, \quad (12)$$

где

$$A(t = -\infty) = \frac{2}{\omega_{pl}} [v_a(T_0) + v_{ep,opt}] \quad (13)$$

– исходный коэффициент поглощения. Соотношение (12) описывает коэффициент поглощения в условиях высоко-частотного скин-эффекта, когда $\omega > v_a'$ (см. (2)). Последнее неравенство налагает ограничение на величину коэффициента поглощения, которая в рамках применимости излагаемого подхода не должна превышать $2\omega/\omega_{pl}$. Максимальное значение $A(t)$ достигается при $t \geq t_p$:

$$A(t \geq t_p) \simeq A(t = -\infty) \frac{1}{\alpha} (e^\alpha - 1) < \frac{2\omega}{\omega_{pl}}, \quad (14)$$

где $\alpha = 16aIt_p/(\pi\sqrt{\pi}\hbar cN)$. Согласно (14) заметное увеличение коэффициента поглощения из-за нагрева электронов возникает при $\alpha > 1$. При $e^\alpha \gg 1$ величина отношения $A(t \geq t_p)/A(t = -\infty)$ определяет параметр α в соответствии с формулой

$$\alpha \simeq \ln \left[\frac{A(t \geq t_p)}{A(t = -\infty)} \ln \left(\frac{A(t \geq t_p)}{A(t = -\infty)} \right) \right]. \quad (15)$$

Поскольку параметры лазерного импульса I и t_p , а также плотность электронов N известны, то экспериментальное измерение отношения коэффициентов поглощения до и сразу после воздействия импульса позволяет найти коэффициент a .

В течение времени эффективного воздействия лазерного импульса, т. е. в интервале $-t_p < t < t_p$, происходит вынос тепла из скин-слоя. Однако в силу правого неравенства (10) такой вынос тепла оказывает слабое влияние на температуру электронов в скин-слое, а следовательно, и на коэффициент поглощения. За время воздействия лазерного импульса на единице площади поверхности металла выделяется тепло

$$Q = \int_{-\infty}^{\infty} dt I(t) A(t) = It_p A(t = -\infty) \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} \int_0^\alpha \frac{dx}{x} (e^x - 1), \quad (16)$$

которое в основном сосредоточено в скин-слое. При $t > t_p$ плотность потока в импульсе экспоненциально быстро убывает и эволюция температуры электронов в значительной мере определяется выносом тепла из скин-слоя в глубь металла. Изменение температуры электронов описывается уравнением (8), в котором при $t > t_p$ приближенно можно пренебречь выделением тепла в скин-слое. Толщина скин-слоя d сравнительно мала, и по истечении небольшого времени ($\sim 3v_\lambda'^2/v_F^2$) размер прогретой области оказывается больше d . На таких временах естественно искать автомодельное решение приближенного уравнения (8), в правой части которого нет первого слагаемого. Отвечающее отсутствию потока тепла на поверхности металла соответствующее автомодельное решение имеет вид

$$v_\lambda' = v_\lambda + v_{ep,\lambda} \simeq v_b = \frac{1}{t} \left[D + \frac{3}{2} \left(\frac{z}{v_F t} \right)^2 \right]^{-1}, \quad (17)$$

где параметр D находится из соотношения

$$\frac{1}{2} \int_0^\infty dz CT = Q. \quad (18)$$

Из (17), (18) находим, что

$$D = \frac{\pi^6}{384} \left(\frac{\hbar v_F N}{Q} \right)^2, \quad (19)$$

где Q описывается выражением (16). Зависимость вида (17) имеет место при $T > T_b$ и описывает эволюцию температуры электронов в прогретой области металла. Размер прогретой области z_h увеличивается пропорционально времени с характерной скоростью $\sqrt{D}v_F$: $z_h \sim \sqrt{D}v_F t$ [14]. При этом температура электронов на поверхности металла убывает обратно пропорционально \sqrt{t} :

$$\frac{k_B T(z=0, t)}{\varepsilon_F} = \frac{Q}{\hbar v_F N \pi^3} \left(\frac{384 \hbar}{b t \varepsilon_F} \right)^{1/2}. \quad (20)$$

В условиях применимости автомодельного решения (17) характерный масштаб неоднородности температуры существенно больше глубины скин-слоя d . Поэтому температура электронов в скин-слое изменяется слабо, а ее величина приближенно описывается соотношением (20). Слабое изменение T внутри слоя глубиной d позволяет записать коэффициент поглощения (6) в следующем виде:

$$\begin{aligned} A(t > t_p) &\simeq \frac{2v'_a(z=0, t)}{\omega_{pl}} \\ &= \frac{2}{\omega_{pl}} \left\{ v_{ep, opt} + a \frac{\varepsilon_F}{\hbar} \left[\frac{k_B T(z=0, t)}{\varepsilon_F} \right]^2 \right\} \\ &\simeq A(t = -\infty) + \frac{a}{b} \left(\frac{Q}{\hbar v_F N} \right)^2 \frac{768}{\pi^6 \omega_{pl}}. \end{aligned} \quad (21)$$

Согласно (21) во временном интервале $t_p < t < t_h$, где

$$t_h = \frac{a}{b} \left(\frac{Q}{\hbar v_F N} \right)^2 \frac{384}{\pi^6 v_{ep, opt}}, \quad (22)$$

коэффициент поглощения в основном определяется электрон-электронными столкновениями с перебросом квазиимпульса и убывает обратно пропорционально времени. Как видно из последнего слагаемого в (21), темп уменьшения $A(t)$ зависит от отношения a/b . Отсюда следует, что из установленной экспериментально зависимости $A(t > t_p) \propto t^{-1}$ можно найти численное значение отношения a/b , поскольку остальные входящие в (21) параметры допускают независимое определение.

Из изложенного выше следует, что при $t \leq t_p$ коэффициент поглощения резко возрастает (см. (12)), достигая максимума при $t \geq t_p$, убывает как $1/t$ в интервале $t_p < t < t_h$ и возвращается к исходному значению $A(t = -\infty)$ при $t > t_h$, где t_h считается малым по сравнению с t_{lat} – временем передачи энергии от электронов к решетке. Если $t_h > t_{lat}$, то зависимость вида $A(t) \propto 1/t$ имеет место до $t < t_{lat}$. Экспериментальное изучение такого поведения коэффициента поглощения позволяет установить численные значения множителей a и b , определяющих эффективные частоты столкновений, которые входят как в коэффициент поглощения, так и в тепловой поток.

Если $t \geq t_{lat}$, то в правую часть уравнения (8) следует добавить слагаемое [15, 16]

$$G(T - T_{lat}), \quad (23)$$

учитывающее передачу энергии от электронов к решетке, где параметр G характеризует связь электронов с решеткой. Например, для золота $G = 3.5 \times 10^{10}$ Вт·см⁻³·К⁻¹ [17]. Обычно слагаемое вида (23) существенно на временах порядка пикосекунд или более. Учет этого слагаемого в уравнении (8) позволяет описать эволюцию температуры электронов и коэффициента поглощения на временах $t \geq t_{lat}$. Тем самым изучение эволюции коэффициента поглощения при $t \geq t_{lat}$ открывает возможность экспериментального определения параметра G .

В настоящее время известны эксперименты (см., напр., [9, 10]), в которых измерен коэффициент отражения пробного фемтосекундного импульса, взаимодействующего с металлом по истечении времени Δt после воздействия основного фемтосекундного импульса, грющего электроны. Предложенный выше подход к описанию эволюции коэффициента поглощения можно использовать для сравнения с экспериментальными данными работы [9]. В [9] приведены относительные изменения коэффициента отражения усредненного по времени действия пробного импульса

$$\begin{aligned} \frac{\Delta R(\Delta t)}{|\Delta R(\Delta t)|_{\max}} &= \frac{R(\Delta t) - R(-\infty)}{|R(\Delta t) - R(-\infty)|_{\max}} \\ &= \frac{A(-\infty) - A(\Delta t)}{|A(-\infty) - A(\Delta t)|_{\max}}, \end{aligned} \quad (24)$$

где использована связь $R = 1 - A$ коэффициентов отражения (R) и поглощения (A) и введено обозначение

$$A(\Delta t) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} dt I_{\text{test}}(t - \Delta t) A(t) \right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} dt I_{\text{test}}(t) \right]^{-1}, \quad (25)$$

в котором $I_{\text{test}}(t)$ – плотность потока энергии в пробном импульсе. Индекс \max в (24) обозначает максимум модуля соответствующей величины. Квадраты на рис.1 отвечают значениям функции $\Delta R(\Delta t)/|\Delta R(\Delta t)|_{\max}^{-1}$ (24), установленным в эксперименте [9]. Эти значения получены при изучении отражения слабого пробного импульса титан-сапфирового лазера длительностью 110 фс от плоской мишени из золота, нагреваемой основным импульсом длительностью 110 фс, плотность потока энергии которого $I = 1.3 \times 10^{12}$ Вт/см². Отметим, что роль межзонных переходов в поглощении излучения такого лазера мишенью из золота можно не учитывать, т. к. для него

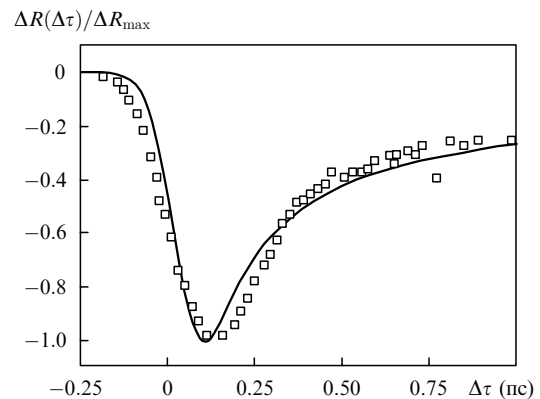


Рис.1. Относительное изменение коэффициента отражения (24) пробного импульса от мишени из золота. Квадраты – данные работы [9], сплошная кривая – расчет.

край межзонных переходов лежит в области $\Delta \approx 2.5$ эВ [18], что больше энергии кванта излучения $\hbar\omega \approx 1.5$ эВ. При таких длительностях и плотностях потока титан-сапфирового лазерного импульса передача энергии в фоновую подсистему несущественна.

Сплошная кривая на рис.1 получена посредством численного решения уравнения (8) и последующего вычисления коэффициента поглощения (6) и относительного изменения коэффициента отражения (24). Расчет выполнен для мишени из золота, для которой $\varepsilon_F = 5.5$ эВ, $N = 5.9 \times 10^{22}$ см⁻³ и $\omega_{pl} = 1.4 \times 10^{16}$ с⁻¹, и для параметров основного импульса из работы [8]. Форма теоретической кривой зависит от эффективных частот столкновений электронов v'_a и v'_λ . При $T_{lat} \approx 300$ К для золота $v_{ep,opt} = 0.93 \times 10^{14}$ с⁻¹ [19] и $v_{ep,\lambda} = 3.6 \times 10^{13}$ с⁻¹ [20]. Вклады v'_a и v'_λ в v'_a и v'_λ от электрон-электронных столкновений зависят от коэффициентов a и b и от температуры электронов. При не малых значениях a и b и быстром нагреве электронов эти вклады становятся доминирующими. При этом v'_a и v'_λ близки к величинам v_a и v_λ и изменяются пропорционально a и b соответственно. Варьируя значения a и b , можно добиться близости теоретической кривой $\Delta R(\Delta t) |\Delta R(\Delta t)|_{\max}^{-1}$ и экспериментальных данных [9]. Сравнительно хорошее соответствие экспериментальных данных и расчета на рис.1 получено при $a \approx 0.5$ и $b \approx 1$.

Анализ данных эксперимента [9] демонстрирует возможность реализации предлагаемого подхода для определения эффективных частот столкновений неравновесных электронов по измерениям коэффициента отражения. Вместе с тем следует подчеркнуть, что точность определения a и b по данным эксперимента [9] сравнительно невелика и чувствительна к форме импульса. Повышение точности возможно при сокращении длительности пробного импульса и уменьшении погрешности измерений коэффициента отражения. Современный эксперимент по-

зволяет как сократить длительность пробного импульса до нескольких фемтосекунд (см., напр., [21]), так и повысить точность оптических измерений.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Фемтосекундная оптика и новые оптические материалы» и РФФИ (грант № 06-02-16153-а).

1. Гинзбург В.Л., Силин В.П. *ЖЭТФ*, **29**, 64 (1955).
2. Лифшиц И.М., Азбель М.Я., Каганов М.И. *Электронная теория металлов* (М.: Наука, 1971).
3. Гантмахер В.Ф., Левинсон И.Б. *Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках* (М.: Наука, 1984).
4. Lugovskoy A.V., Bray I. *Phys. Rev. B*, **60** (5), 3279 (1999).
5. Fisher D., Fraenkel M., Henis Z., Moshe E., Eliezer S. *Phys. Rev. E*, **65**, 016409 (2001).
6. Yoneda H., Morikami H., Ueda K., More R.M. *Phys. Rev. Lett.*, **91** (7), 075004 (2003).
7. Ландау Л.Д., Померанчук И.Я. *ЖЭТФ*, **7**, 379 (1937).
8. Абрикосов А.А. *Основы теории металлов* (М.: Наука, 1987).
9. Guo C., Rodrigues G., Taylor A.J. *Phys. Rev. Lett.*, **86** (8), 1638 (2001).
10. Guo C., Taylor A.J. *Phys. Rev. B*, **62** (18), R11921 (2000).
11. Гуржи Р.Н. *ЖЭТФ*, **35**, 965 (1958).
12. Займан Дж. *Электроны и фононы* (М.: ИЛ, 1962, гл.7).
13. Lawrence W.E. *Phys. Rev. B*, **13**, 5316 (1976).
14. Kanavin A.P., Smetanin I.V., Isakov V.A., Afanasiev Yu.V., Chichkov B.N., Wellegehausen B., Nolte S., Momma C., Tunnermann A. *Phys. Rev. B*, **57**, 14698 (1998).
15. Каганов М.И., Лифшиц И.М., Танатаров Л.В. *ЖЭТФ*, **31**, 2232 (1957).
16. Анисимов С.И., Копелиович Б.Л., Перельман Т.Л. *ЖЭТФ*, **66**, 776 (1974).
17. Groeneveld R.H., Sprik R., Lagendij K.A. *Phys. Rev. B*, **45**, 5079 (1992).
18. Theye M.-L. *Phys. Rev. B*, **2**, 3060 (1970).
19. Jonson P.B., Christy R.W. *Phys. Rev. B*, **6**, 4370 (1972).
20. *Физические величины. Справочник*. Под ред. И.С.Григорьева, Е.З.Мейлихов (М.: Энергоатомиздат, 1991).
21. Schenkel B., Biegert J., Keller U., Vozzi C., Nisoli M., Sansone G., Stagira S., Silvestri S.De, Svelto O. *Opt. Lett.*, **28**, 1987 (2003).